



# ОДНОПЕРЕХОДНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

КТ117А, КТ117Б, КТ117В, КТ117Г

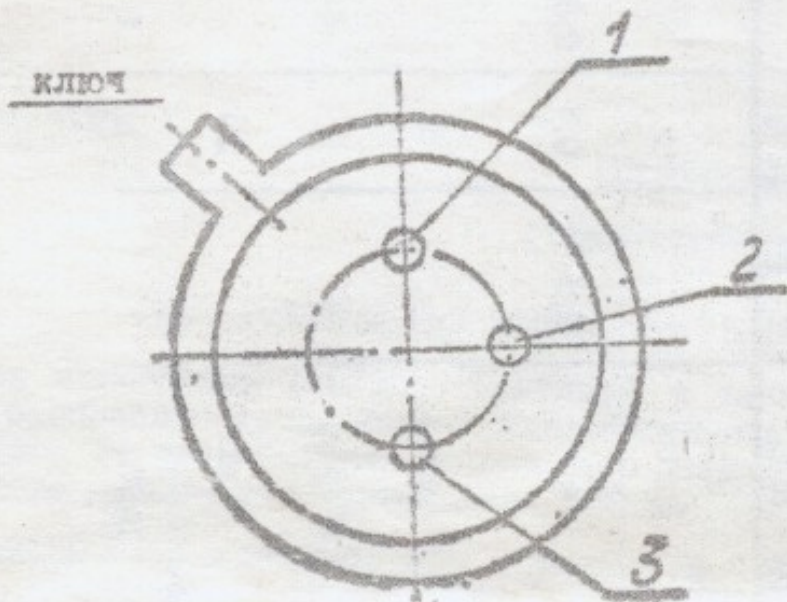


## ЭТИКЕТКА

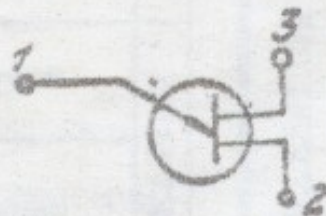
Кремниевые планарные однопереходные р-п проводимости транзисторы КТ117А, КТ117Б, КТ117В, КТ117Г в металлокерамическом корпусе предназначены для работы в схемах запуска различных электронных устройств, в схемах длительной задержки и в преобразователях.

Климатическое исполнение УХЛ3

*Схема расположения выводов*



*Схема соединения электродов с выводами*



Обозначение вывода	Наименование электрода
1	Эмиттер
2	База 1
3	База 2

**ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ  
ТЕМПЕРАТУРЕ (25±10)°С**

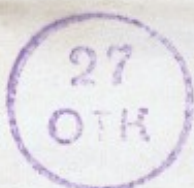
Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма							
		КТ117А		КТ117Б		КТ117В		КТ117Г	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Ток утечки эмиттерного перехода (U в1в2 = 30 В), мкА	I эво		1		1		1		1
Коэффициент передачи (U в1в2 = 10 В)	к	0,5	0,7	0,65	0,9	0,5	0,7	0,65	0,9
Остаточное напряжение (U в1в2 = 10 В, Iэ = 50 мА), В	U вэнас		5		5		5		5
Межбазовое сопротивление (I в1в2 = 1 мА), кОм	R в1в2	4	9	4	9	8	12	8	12
Ток включения (U в1в2 = 10 В), мкА	I эв		20		20		20		20
Ток выключения (U = 20 В), мА	I off	1		1		1		1	

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов:  
золото—8,7574 г, в том числе на 3 выводах длиной  $(135 \pm 1)$  мм  
при толщине покрытия выводов 3 мкм золота содержится 3,4362 г.  
Цветных металлов не содержится.

### СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Однопереходные транзисторы КТ117А-Г соответствуют техниче-  
ским условиям 3.365.002 ТУ.

Штамп ОТК



Штамп представителя  
Государственной приемки



Перепроверка произведена \_\_\_\_\_  
дата

Штамп ОТК

Штамп представителя  
Государственной приемки

### УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. При проведении входного контроля, а также при монтаже и ремонте радиоаппаратуры необходимо применять меры по защите транзисторов от воздействия статического электричества. Допустимое значение статического потенциала 500 В.
2. Транзисторы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки и паяльником. При групповой пайке температура не выше  $265^{\circ}\text{C}$ , время не более 4 с.
3. Пайку проводят на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзисторов. При пайке температура корпуса транзисторов не должна превышать  $125^{\circ}\text{C}$ . Число допустимых перепаек транзисторов при проведении монтажных (сборочных) операций не более 6 (трехкратная пайка).
4. Изгиб выводов транзисторов допускается производить на расстоянии не менее 3 мм от корпуса с радиусом закругления 1,5 мм.
5. При всех условиях и режимах применения транзисторы не должны находиться при температуре окружающей среды ниже минус  $60^{\circ}\text{C}$ , температура корпуса не должна превышать  $125^{\circ}\text{C}$ .